



(11) RO 135074 A2

(51) Int.Cl.

C23C 14/35 (2006.01),

B82B 3/00 (2006.01),

B82Y 30/00 (2011.01)

(12)

## CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2019 00870**

(22) Data de depozit: **05/12/2019**

(41) Data publicării cererii:  
**30/06/2021** BOPI nr. **6/2021**

(71) Solicitant:  
• **INSTITUTUL NAȚIONAL DE  
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU  
FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI  
RADIATIEI-INFLPR, STR. ATOMIȘTILOI  
NR.409, MĂGURELE, IF, RO**

(72) Inventatori:  
• **ACSENTE TOMY,  
BLV. NICOLAE GRIGORESCU, NR.36,  
BL.S1D, SC.A, ET.9, AP.45, SECTOR 3,  
BUCUREȘTI, B, RO;**  
• **DINESCU GHEORGHE, STR.BÂRCĂ,  
NR.17, BL.M8, AP.17, SECTOR 5,  
BUCUREȘTI, B, RO**

### (54) METODA DE OPERARE ÎN REGIM JET DE PLASMĂ DE TEMPERATURĂ JOASĂ A UNEI SURSE DE CLUSTERI BAZATĂ PE PULVERIZARE MAGNETRON ȘI AGREGAREA ÎN GAZ

(57) Rezumat:

Invenția se referă la o metodă de operare a unei surse de clusteri bazată pe pulverizare magnetron în combinație cu agregarea în gaz inert a atomilor generați în descărcarea magnetron. Metoda conform inventiei constă în generarea unui jet de plasmă care emerge împreună cu clusterii dintr-o sursă de clusteri și pătrunde într-o incintă de colectare la care este atașată sursa de clusteri. Prin această metodă, injectând un gaz reactiv în jetul de plasmă, imediat după ieșirea acestuia din sursa de clusteri, se modifică starea

chimică a suprafeței nanoparticulelor obținute, în timpul deplasării acestora către un substrat plasat în camera de colectare. Jetul de plasmă obținut prin această metodă este caracterizat de o temperatură redusă, ceea ce permite depunerea nanoparticulelor cu suprafață modificată pe materiale susceptibile la degradare termică, cum ar fi, de exemplu, polimerii.

Revendicări: 3

Figuri: 4

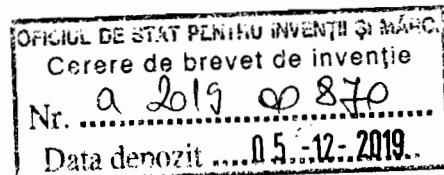
Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



**Metoda de operare in regim jet de plasma de temperatura joasa a unei surse de clusteri bazata pe pulverizare magnetron si agregarea in gaz.**

Autori:

INFLPR: Tomy Acseente, Dinescu Gheorghe.



## **DESCRIEREA INVENȚIEI**

### **Domeniul invenției**

Aceasta inventie se referă la un regim nou de operare a unei surse de clusteri bazata pe pulverizare magnetron in combinatie cu agregarea in gaz inert a atomilor ejectati din tinta magnetron. Noul regim de operare consta in generarea unui jet de plasma care emerge din sursa de clusteri si patrunde in incinta de colectare a clusterilor; in modul clasic de operare jetul de plasma este absent. Ambele moduri de operare ale sursei de clusteri permit obtinerea de nanoparticule. Acest aspect este demonstrat in aceasta inventie pentru nanoparticulele de wolfram si compusi ai acestuia sintetizate in regimul jet de plasma. Avantajul principal al modului de lucru cu jet de plasma fata de modul clasic de operare este ca starea chimica a suprafetei nanoparticulelor metalice obtinute in sursa de clusteri poate fi modificata intr-un mod facil, prin injectarea in jetul de plasma a gazelor reactive corespunzatoare. De asemenea, temperatura jetului de plasma este redusa, ceea ce permite depunerea nanoparticulelor pe materiale sensibile la temperatura (cum ar fi polimerii).

### **Baza invenției**

Inventia este in stransa legatura cu domeniul sintezei de nanoparticule folosind plasma (descarcari in gaze). Ea combina doua dispozitive bazate pe plasma: i) sursele de clusteri bazate pe pulverizare magnetron si agregarea in gaz inert a vaporilor obtinuti prin imprastiere magnetron; si ii) sursele de tip jet de plasma.

Nanoparticulele au capat in ultimele decenii o atentie deosebita atat in lumea academica dar si in cea tehnologica. Acest interes se datoreaza in principal proprietatilor deosebite (cum ar fi cele optice, electrice, magnetice, chimice sau antibacteriene) pe care le poseda nanoparticulele. Din acest motiv, nanoparticule din diverse materiale au inceput deja sa fie utilizate in diferite domenii (de exemplu medicina), fiind integrate in diverse dispozitive tehnologice dar si in materiale noi (de exemplu pentru cataliza si fotocataliza).

In prezent exista o diversitate de metode de producere a nanoparticulelor, atat chimice cat si fizice. Cele din urma, in special cele bazate pe descarcarile electrice in gaze (plasma), se evidențiază prin puritatea chimica a nanoparticulelor sintetizate.

Dintre sursele de nanoparticule (nanoclusteri) care utilizeaza descarcarile electrice in gaze se evidențiază cele bazate pe pulverizare magnetron combinata cu agregarea in gaz, care au fost dezvoltate initial in anii 1990 de catre H. Haberland (Zeitschrift Fur Phys. D Atoms, Mol. Clust., 20, 413, 1991).

Din punct de vedere constructiv instalatiile de producere de nanoparticule care folosesc sursele de clusteri sunt constituite din doua incinte de vid, una care adaposteste sursa

de clusteri si una care are rol de camera de colectare ; cele doua incinte comunica intre ele printr-un orificiu (duza sursei de clusteri).

Nanoparticulele sunt produse in camera vidata a sursei de clusteri (denumita si camera de agregare) prin agregare din atomii obtinuti in urma pulverizarii suprafetei unei tinte constituita din materialul de interes.

Pulverizarea are loc in urma bombardarii tintei cu ioni energetici produsi in plasma tip magnetron, care se genereaza intr-un gaz inert (de regula argon, dar nu numai). Atomii pulverizati din tinta, indepartandu-se de substrat, ajung intr-o zona racita a camerei de agregare, in care presiunea lor parciala devine suprasaturanta datorita scaderii temperaturii. Acest lucru faciliteaza nucleatia nanoparticulelor: astfel, in urma ciocnirii atomilor pulverizati din tinta cu cei ai gazului de lucru rezulta dimeri de tip metal-metal in cazul nucleatiei omogene. La aceste nuclee initiale adera in continuare atomi pulverizati din tinta, conducand la formarea nanoparticulelor din materialul tintei.

Procesul de formare al nanoparticulelor are loc simultan cu deplasarea acestora catre orificiul de iesire al sursei de clusteri, datorita antrenarii de catre curentul de gaz inert. Rezulta in acest fel un fascicul de nanoparticule care emerge datorita fluxului de gaz, din sursa de clusteri in camera de colectare. Plasand un substrat in calea fluxului de gaz, pe acesta se vor colecta nanoparticulele produse in sursa de clusteri.

In regimul clasic de operarea al sursei de clusteri plasma este confinata in interiorul acesteia.

Un alt instrument tehnologic bazat pe descarcari in gaze (plasma), avand diverse aplicatii tehnologice, il reprezinta sursele de plasma tip jet de plasma.

Exista diverse tipuri de jeturi de plasma, clasificate dupa criterii specifice, cele mai comune fiind temperatura plasmei (de temperatura inalta sau joasa) sau presiunea de lucru (la joasa presiune sau la presiune atmosferica).

Jeturile de plasma au diverse aplicatii tehnologice, cateva dintre ele fiind:

- i) Modificarea chimiei suprafetelor prin expunerea lor la un jet de plasma produs intr-un gaz care prezinta reactivitate chimica cu materialul suprafetei de prelucrat;
- ii) Sinteza de nanomateriale (cum ar fi cele carbonice, de tip nanofibre si nanopereti de carbon) in urma injectarii de precursori chimici (cum ar fi acetilena) in jet ;
- iii) Sinteza de nanoparticule (cum ar fi cele metalice) in urma topirii si evaporarii electrozilor descarcarii.
- iv) Realizarea de acoperiri prin procedeul plasma-spray;
- v) Prelucrarea metalelor (taiere si sudura) folosind jeturi de plasma de temperatura ridicata care folosesc arcul electric.

Prezenta inventie aduce in atentie o sursa de particule care utilizeaza o sursa de clusteri bazata pe pulverizare magnetron si agregare in gaz inert care functioneaza in regim de jet de plasma, precum si posibilele aplicatii ale acestuia.

Jetul de plasma se obtine in conditii specifice de operare a sursei de clusteri. Acestea permit expansiunea plasmei din camera de agregare a sursei de clusteri in incinta de colectare la care este atasata sursa.

Sursele de clusteri bazate pe pulverizare magnetron si agregare in gaz inert sunt versatile si sunt utilizate pe scara larga pentru producerea nanoparticulelor (atat metalice cat si din polimeri).

Cu toate acestea, acest tip de surse de clusteri intampina dificultati in producerea de nanoparticule din compusi ai metalelor (oxizi, nitruri, carburi, etc.).

In situatia in care se intentioneaza obtinerea de nanoparticule direct din o tinta de compus metalic, producerea lor este obstructionata in primul rand de randamentul foarte redus de pulverizare in plasma al compusilor metalici in comparatie cu metalul respectiv.

In situatia in care se intentioneaza obtinerea de nanoparticule prin pulverizare magnetron reactiva (folosind o tinta metalica si introducand un gaz reactiv in camera de agregare - de exemplu N<sub>2</sub> sau O<sub>2</sub> pentru obtinerea de nanoparticule de nitruri sau oxizi metalici), procesul de pulverizare magnetron devine greu de controlat datorita particularitatilor acestui tip de proces (una din ele fiind posibila otravire a tintei si reducerea drastica a randamentului de pulverizare a tintei).

Inventia ofera posibilitatea de modificare a naturii chimice a nanoparticulelor prin introducerea gazului reactiv la iesirea din sursa de clusteri, in jetul de plasma. Modificarea starii chimice a nanoparticulelor are loc pe durata transportului acestora catre substrat.

Inventia ofera posibilitatea de depunere a nanoparticulelor pe substraturi sensibile la temperatura (cum ar fi polimerii) deoarece jetul de plasma provenind din sursa de clusteri produce o incalzire neglijabila a substratului. Posibila aplicatie in acest caz il reprezinta dezvoltarea de biosenzori.

Mai multe lucrari prezinta producerea de materiale nanometrice (nanoparticule sau nanostructuri) folosind surse de clusteri bazate pe pulverizare magnetron si condensare in gaz inert pe de o parte, si folosind jeturi de plasma pe de alta parte.

Astfel:

Se cunoaste din brevetul US 00614505A o metoda de producere a unor straturi de nanoparticule de Al bazata pe pulverizarea magnetron, cu folosirea lor ulterioara in dispositivo cu tunelare cuantica. Dispozitivul este in esenta o sursa de nanoparticule bazata pe pulverizare magnetron si condensare in gaz inert, anume He. Oxidarea pe suprafata a nanoparticulelor se realizeaza de resturile de vaporii de apa reziduali in rezervorul de He. Plasma este confinata in interiorul sursei de nanoparticule.

Se mai cunoaste din brevetul US 20110209987A1 o metoda de producere a nanoparticulelor amorse si cristaline de Si folosind o sursa de nanoclusteri bazata pe pulverizare magnetron si agregare in gaz, in un amestec de Ar si H<sub>2</sub>. Aceasta din urma previne oxidarea tintei de Si si reduce tensiunea de suprafata a nanoparticulelor produse. Plasma este confinata in interiorul sursei de nanoparticule.

Se mai cunoaste si patentul EP 0522842A1 referitor la o torta de plasma care genereaza un jet de plasma destinat acoperirii cu diamant sintetic a substraturilor, folosind ca si gaz de lucru un gaz continand carbon.

Se mai cunoaste si patentul EP3206728A1 referitor la o metoda de crestere a nanoparterilor verticali de carbon pe dipozitive implantabile medical, folosind un jet de plasma la presiune joasa.

Se mai cunoaste si patentul DE10031002A1 referitor la modificarea starii chimice (oxidarea sau nitrurarea) a unei suprafete (metalice sau de carbon) folosind un fascicul de plasma la presiune joasa.

Gunnarsson R. si coautorii (J. Nanopart. Res., 17, 353, 2015) au raportat sinteza de nanoparticule de oxid de titan avand dimensiune si stoichiometrie controlata, folosind o descarcare cavitara care expandeaza in o camera vidata.

Lazea-Stoyanova A. si coautorii (Dig. J. Nanomater. Bios., 9, 3, 2014) au raportat producerea de nanoparticule metalice (Cu sau W) folosind un jet de plasma la presiune atmosferica.

Choukourov A. si colaboratorii (Beilstein J. Nanotechnol., 8, 2002–2014, 2017) au raportat modificarea starii chimice a suprafetei nanoparticulelor de Ag generate cu o sursa de clusteri bazata pe pulverizare magnetron si agregare in gaz folosind o descarcare in plasma in camera de depunere (sau de colectare), pozitionata intre duza sursei de clusteri si substrat.

Nanoparticulele de Ag isi modifica chimia suprafetei la trecerea lor prin aceasta plasma. Plasma magnetron este confinata in interiorul sursei de nanoparticule si nu expandeaza in camera de agregare, fiind total independenta de plasma din camera de colectare.

### **Prezentarea pe scurt a figurilor**

Figura 1 prezintă o vedere schematică în secțiune longitudinală al sursei de clusteri bazata pe descarcarea magnetron si condensare in gaz inert, exemplificata pentru regimul jet de plasma.

Figura 2 prezintă o imagine a jetului de plasma si a substratului. In imagine se observa depunerea obtinuta pe un substrat plasat in incinta de depunere.

Figura 3 prezinta imaginea de microscopie electronica de baleaj (SEM) a nanoparticulelor depuse pe substrat in modul jet, cu O<sub>2</sub> injectat in jetul de plasma, la iesirea din sursa de clusteri.

Figura 4 prezinta spectrul de fotoelectroni de raze X (XPS) inregistrat in zona W4f pe proba de nanoparticule depusa in modul jet, cu O<sub>2</sub> injectat in jetul de plasma, la iesirea din sursa de clusteri.

### **Definiția termenilor**

În general termenii tehnici sau frazele care apar in acest text sunt folosiți ca atare, fiind uzuali persoanelor care au aptitudini in tehnologiile legate de plasma si de sinteza nanoparticulelor; pentru o mai bună înțelegere a lor au fost selectate definiții, dupa cum urmează.

**Plasma:** se referă la un mediu gazos ionizat ce conține purtători liberi de sarcină (electroni și ioni) și particule neutre excitate (atomi, molecule, radicali). Datorită prezentei purtătorilor liberi de sarcină, plasma este conductivă, prezintă un grad ridicat de interacție între constituenții săi și, în plus, răspunde la acțiunea câmpurilor electrice și magnetice. Mai mult, datorită interacției chimice și fizice a atomilor excitați, moleculelor, radicalilor, ionilor, electronilor, fotonilor cu suprafețe, proprietățile chimice și fizice ale acestora se modifică.

**Jet de plasma:** un flux de plasma directional ejecțat dintr-un dispozitiv sau obiect care produce plasma, cum ar fi o tortă de plasma, o stea, etc.

**Pulverizare a unei tinte in plasma:** ejecțarea atomilor dintr-un material (denumit tinta, de obicei avand forma unui disc) in urma bombardarii tintei cu ioni produsi in plasma (de obicei ai unui gaz neutru, cum ar fi, dar nu numai, Ar<sup>+</sup>). In urma pulverizării tintei se obtin atomi din materialul tintei care pot fi directionati catre un obiect (substrat) pentru formarea unui film subtire (depunere, acoperire) pe suprafata acestuia. Acest proces este utilizat pe scara largă pentru acoperirea funcțională a diverse suprafete cu filme subțiri. Metoda este folosita insa si pentru obtinerea clusterilor atomici, prin condensarea vaporilor.

**Magnetron:** dispozitiv care combina campuri electrice si magnetice puternice pentru a confina plasma in vecinatatea tintei; in acest mod se maresteste rata de pulverizare a tintei.

**Condensare:** proces invers vaporizării, implicand schimbarea starii de agregare din stare gazoasa in stare lichida sau solida.

**Clusteri:** in fizica semnifica particule mici, multiatomice.

**Nanoparticule:** particule cu dimensiuni intre 1 si 100 nm.

**Sursa de clusteri (nanoparticule):** dispozitiv care produce nanoparticule pe baza unor proces fizic sau chimic, sau o combinatie a acestora. Nanoparticulele pot fi produse prin doua strategii: "de la mare la mic" si "de la mic la mare". Prima strategie implica metode mecanice de reducere a dimensiunii materialelor macroscopice (macinare). A doua strategie implica agregarea atomilor produsi prin o metoda oarecare. In prezenta inventie se utilizeaza a doua

strategie, atomii fiind produsi prin pulverizare magnetron iar agregarea acesora realizandu-se prin condensarea acestora in un flux de gaz inert.

### Prezentarea detaliată a invenției

Obiectul invenției îl constituie metoda de operarea în modul jet de plasma de temperatură joasă a unei surse de clusteri bazată pe pulverizare magnetron și agregarea în gaz și utilizarea ei pentru sinteza de nanoparticule cu suprafața modificată chimic.

Fig.1 prezintă schematic în secțiune transversală o sursă de clusteri bazată pe pulverizare magnetron și agregarea în gaz. Aceasta constă într-o incintă de vid (1) în care este montată axială o sursă de plasma cu pulverizare de tip magnetron (2) prevăzută cu o tinta (4); în abordarea prezentată aici tinta este metalică, din W, însă poate fi din orice alt material. Incinta sursei de clusteri prezintă în partea opusă tintei un orificiu plasat axial (7) care comunica cu incinta de depunere (10). Regiunea situată între tinta și orificiul de ieșire se numește zona de agregare (6). În această zonă, care este racită (5), are loc creșterea nanoparticulelor prin condensarea vaporilor imprăștiati din tinta. În incinta de depunere este poziționat substratul (9), pe care se depun nanoparticulele. Aceasta este o placă metalică dar poate fi și din sticlă, siliciu, sau material sensibil la temperatură (cum ar fi o folie polimerică). Gazele de lucru sunt introduse în proces în mod controlat, la debit constant, astfel încât presiunea în camera de agregare să fie cu un ordin de marime mai mare decât în incinta de depunere. Gazul de lucru din sursa de clusteri (3) este Ar (însă poate fi orice alt gaz inert adecvat procesului de imprăștiere magnetron, cum ar fi Kr). Acesta are roluri multiple: susține descarcarea electrică, contribuie la procesul de nucleație și antrenează nanoparticulele spre camera de depunere. Gazul reactiv (12) este introdus în mod controlat în camera de depunere, în imediata vecinătate a orificiului de ieșire. Gazele de lucru sunt evacuate cu un sistem de vidare (11) atașat la incinta de depunere.

În condiții tipice de operare, plasma descarcării magnetron este limitată în interiorul sursei de clusteri, în apropierea tintei și extinzându-se într-o masură mai mare sau mai mică în zona de agregare. În aceste condiții, nanoparticulele sunt ejective din sursa de clusteri prin orificiul de ieșire sub formă unui fascicul de nanoparticule.

În anumite condiții experimentale, când grosimea paturii de sarcină spatială de la perete devine mai mică sau comparabilă cu diametrul orificiului de ieșire din sursa de clusteri, plasma expandează în afara sursei de clusteri, sub formă unui jet de plasma.

Jetul de plasma format este exemplificat de imaginea foto prezentată în Fig.2. În aceasta se observă orificiul de ieșire din sursa de clusteri (6), jetul de plasma (8), tubul de injectie a gazului reactiv (12) și substratul (9), pe care se identifică materialul depus de jetul de plasma.

Grosimea paturii de sarcină spatială de la perete este o funcție descreșcătoare de puterea aplicată descarcării și de presiune, astfel încât pentru diametre foarte mici ale orificiului de ieșire transferul plasmei nu se poate realiza, sursa de clusteri neputând lucra în regimul jet de plasma.

În configurațiile specifice de lucru ale unei surse de clusteri se identifică un diametru optim pentru care sursa de clusteri poate lucra atât în regimul clasic cât și în regimul jet de plasma. Tranzitia între cele două regimuri se realizează pentru o valoare specifică a distanței tinta – orificiu, în condițiile în care puterea aplicată descarcării și presiunea de lucru au valoare constantă.

Depunerea de nanoparticule în regimul jet de plasma este demonstrată aici folosind o tinta de W și gaze de lucru Ar (în sursa de clusteri) și O<sub>2</sub> (în jetul de plasma, în vederea oxidării suprafetei nanoparticulelor).

In Fig. 3 este prezentata imaginea de microscopie electronica cu baleiere SEM a nanoparticulelor depuse pe substrat; dimensiunea nanoparticulelor este cuprinsa intre 20 si 40 nm.

Analiza elementala a suprafetei probei depuse in aceste conditii experimentale a fost efectuata prin spectroscopia de fotoelectroni de raze X (XPS). Fig. 4 prezinta spectrul XPS de inalta rezolutie in zona W4f. Se remarcă in acest spectru prezenta celor doua maxime asignate  $\text{WO}_3$  si a celor doua maxime asignate W metalic. Deoarece adancimea de patrundere a razelor X este de maxim 20 nm in tehnica XPS iar dimensiunea nanoparticulelor este cuprinsa intre 20 si 40 nm, spectrul XPS din Fig. 4 sugereaza ca nanoparticulele au fost oxidate eficient (unele in totalitate iar altele cu o coaja de oxid, miezul acestora ramanand metalic).

Temperatura substraturilor expuse la jetul de plasma nu a depasit 60 °C in timpul depunerilor. Testele de depunere de nanoparticule de W metalic pe substrat de PET (polietilena teraftalat) au aratat ca dupa expunerea substratului la jetul de plasma acesta isi pastreaza integritatea.

#### **Obiectivele invenției constă în:**

Operarea surselor de clusteri bazate pe pulverizare magnetron si agregare in gaz inert in regimul jet de plasma, si aplicarea acestui regim de operare pentru sinteza de particule cu suprafata modificata chimic.

**REVENDICĂRI:**

1. Regim de operare al sursei de clusteri bazata pe pulverizare magnetron si agregare in gaz inert, anume regimul jet de plasma, **caracterizat prin aceea ca**, in conditii specifice de operare a sursei de plasma, pentru care grosimea paturii de sarcina spatiala de la perete este mai mica decat diametrul de iesire al sursei de clusteri, plasma expandeaza in afara sursei, in incinta de depunere, sub forma unui jet de plasma.
2. Metoda de modificare a naturii chimice a suprafetei nanoparticulelor generate **conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca** se injecteaza gaz reactiv in jetul de plasma care evolueaza in camera de depunere iar natura chimica a suprafetei nanoparticulelor se modifica datorita interactiei lor cu plasma reactiva, in timpul deplasarii acestora prin camera de colectare catre substrat.
3. Metoda de depunere a nanoparticulelor generate **conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca**, datorita temperaturii reduse a jetului de plasma, substratul folosit nu se deterioreaza desi este sensibil la distrugere cu temperatura.

## Desenele explicative

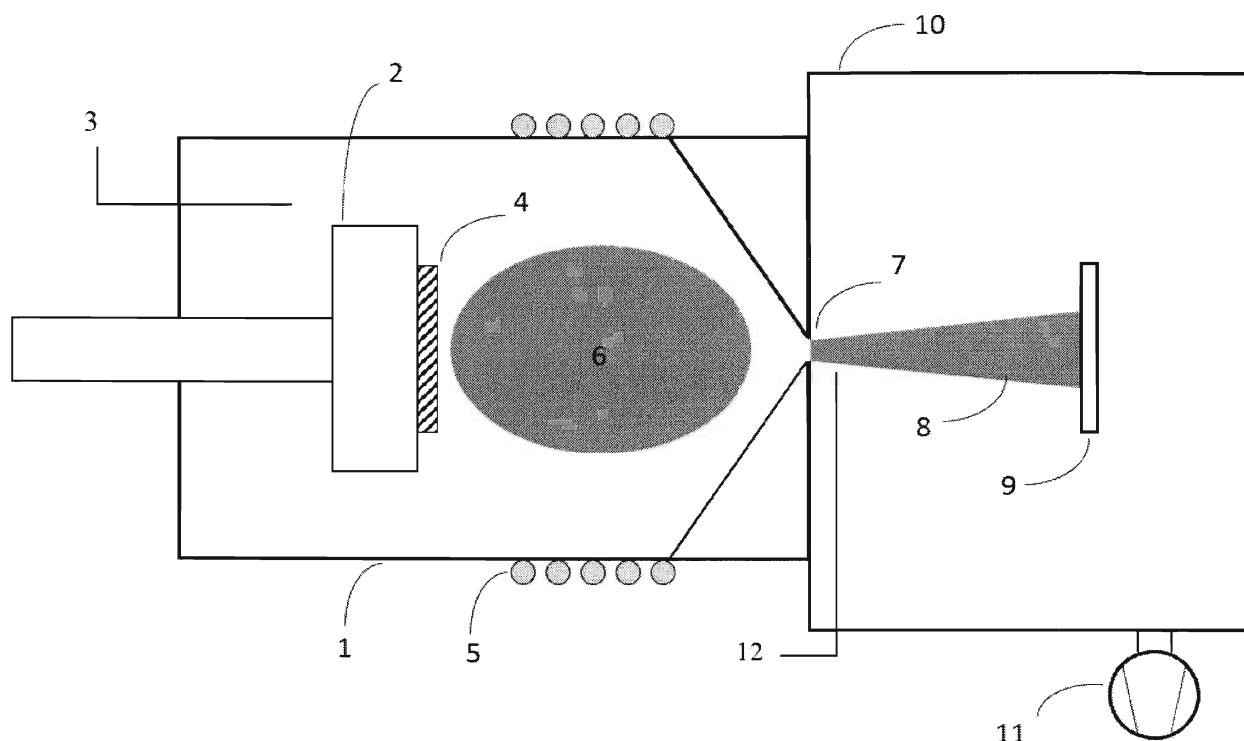


Figura 1

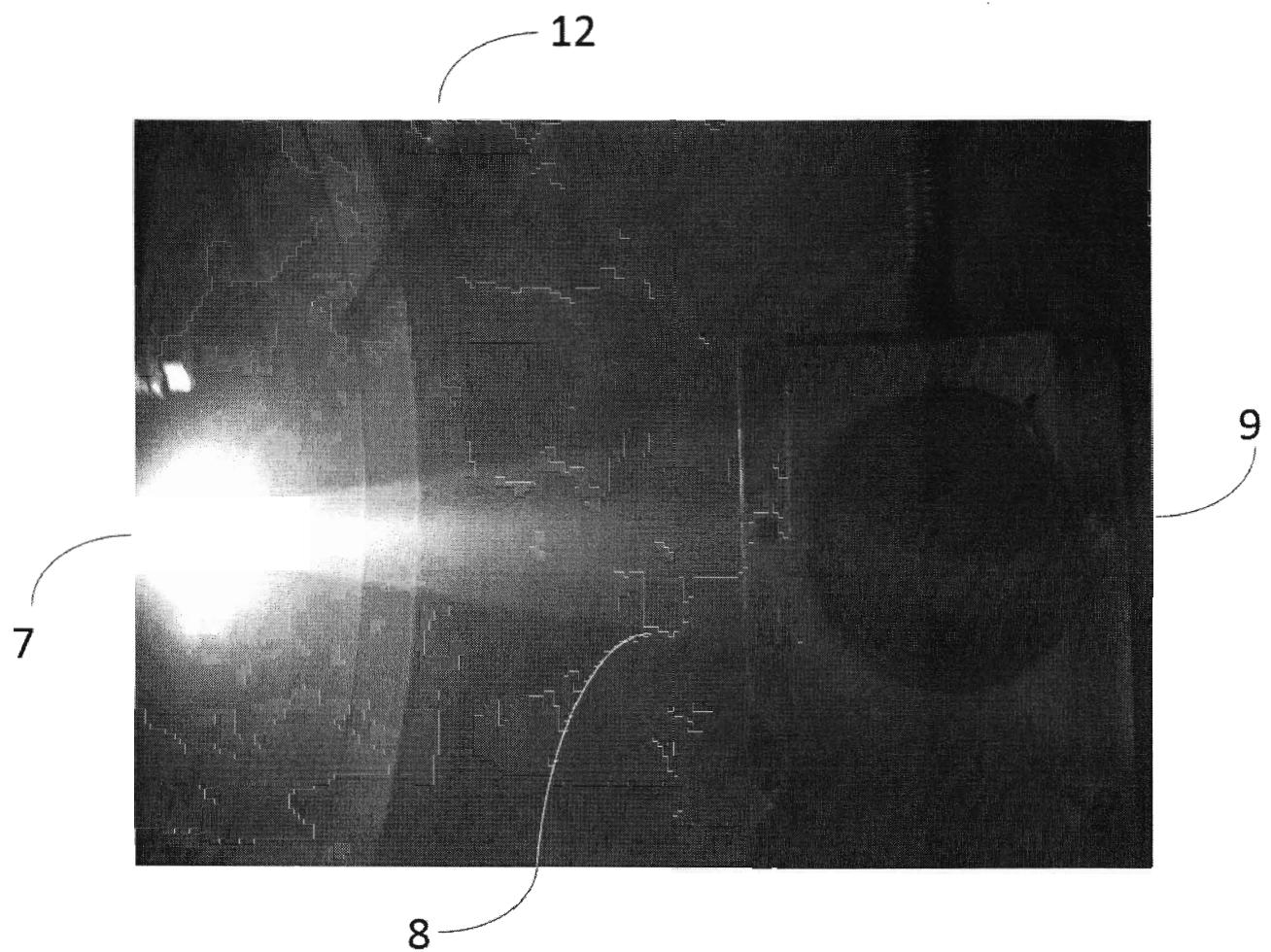


Figura 2

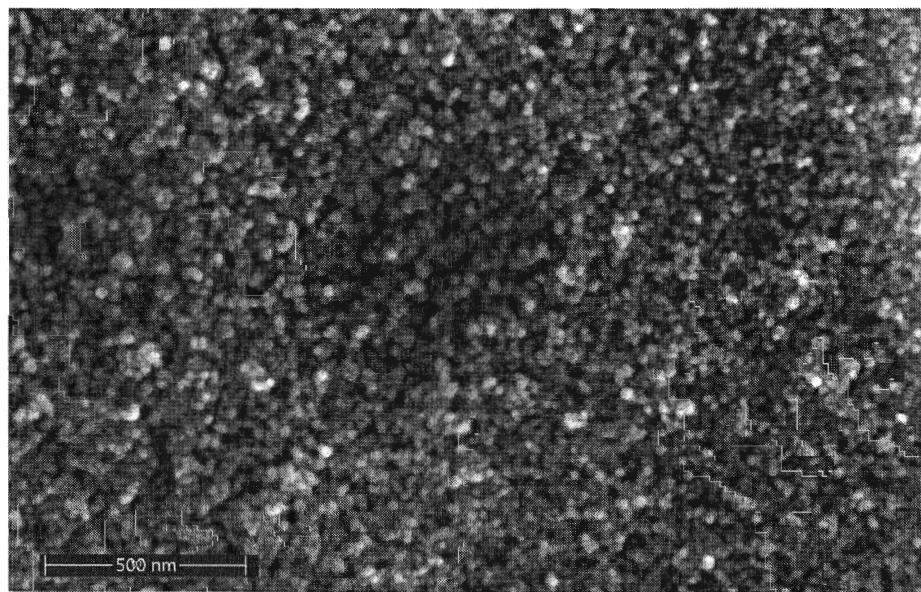


Figura 3

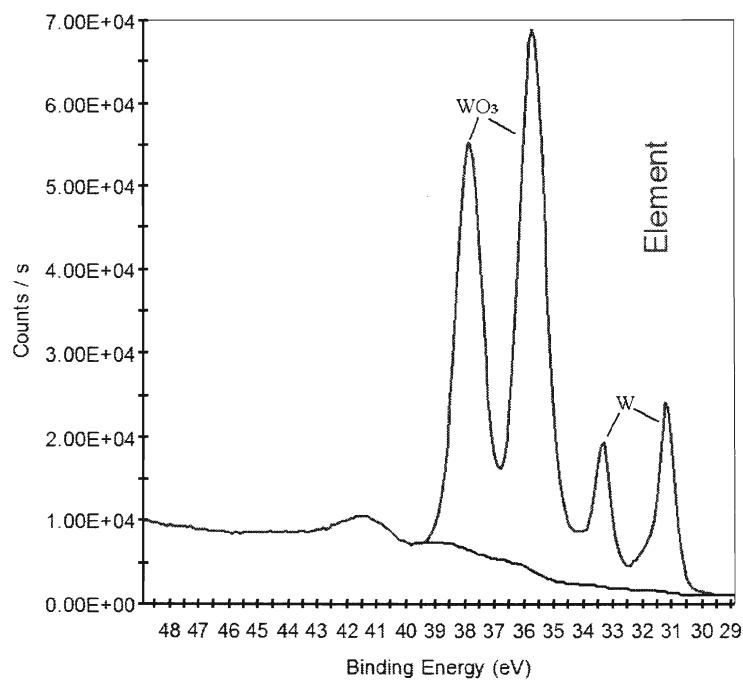


Figura 4